

# 深圳市泉光半导体有限公司

双向可控硅芯片

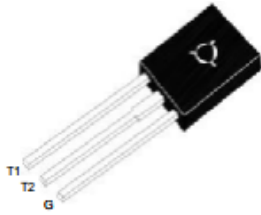
BT134-600

## ■用 途

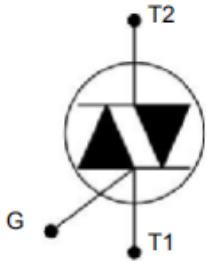
主要用于调光、调温等调压电路，微波炉、洗衣机、电风扇、饮水机、夜明灯等家电的控制电路及用于交流相控、变频器和固态继电器等电路中。

## ■特 征

较低的通态压降，可靠性高。



TO-126 Plastic Package



芯片尺寸	1.5×1.5mm <sup>2</sup>
压焊区尺寸	控制区:325×325μm <sup>2</sup> 阴极区:910×910×3/4μm <sup>2</sup>
芯片厚度	200~220μm
金属层	正面:Al 背面:Ti-Ni-Ag

## ■极限值

名 称	符 号	规范值	单 位	测试条件
重复峰值阻断电压	$V_{DRM}$	>600	V	$I_{DRM}=20\mu A$
通态电流	$I_T (RMS)$	4	A	正弦波 180 度
浪涌电流	$I_{TSM}$	25	A	正弦波 60Hz
结温	$T_j$	125	°C	
贮存温度	$T_{stg}$	-40~150	°C	

## ■电特性( $T_a=25^\circ C$ )

名 称		符 号	测 试 条 件	Min	Max	单 位	
通态电压		$V_{TM}$	$I_T=5A$	--	1.7	V	
维持电流		$I_H$	$V_D=12V, I_{GT}=100mA$	--	15	mA	
门极触发电流	I	$I_{GT}$	T2(+),G(+)	$V_D=12V, R_L=100\Omega$	--	10	mA
	II		T2(+),G(-)		--	10	mA
	III		T2(-),G(-)		--	10	mA
	IV		T2(-),G(+)		--	25	mA
门极触发电压	I	$V_{GT}$	T2(+),G(+)	$V_D=12V, R_L=100\Omega$	--	2	V
	II		T2(+),G(-)		--	2	V
	III		T2(-),G(-)		--	2	V
	IV		T2(-),G(+)		--	2.5	V
换向电压临界上升率		$(dV/dt)_c$	$V_{DM}=400V, T_j=95^\circ C$ $(dI/dt)_c=1.8A/ms$ Gate open	10		V/μs	

地 址: 广东省深圳市龙岗区龙兴路

电 话: 0755-82812899

网 址: <http://www.qgbdt.com>

传 真: 0755-82812938